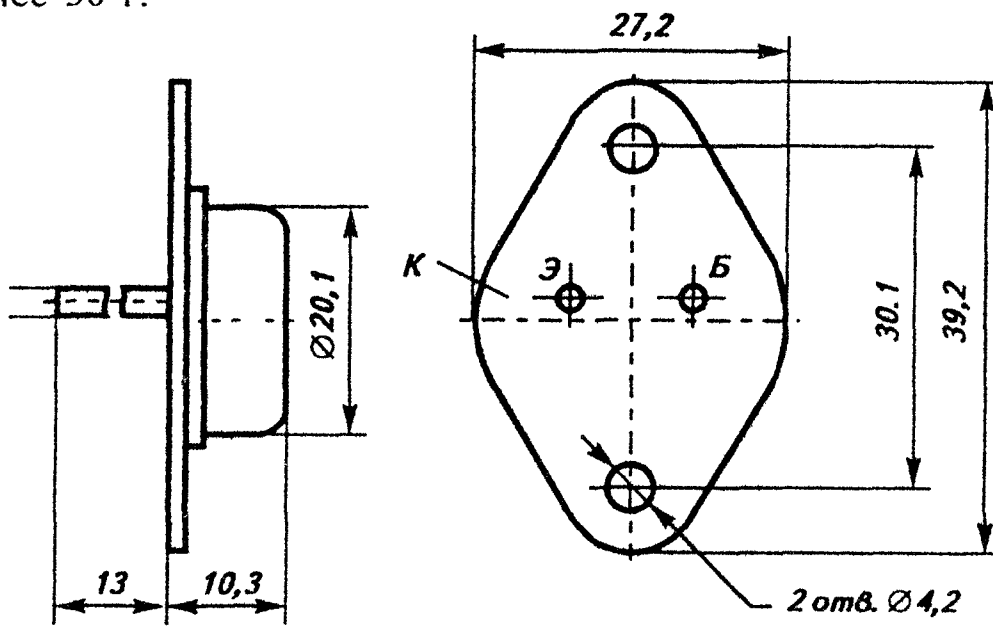


## □ 2Т847А, 2Т847Б

Транзисторы кремниевые меза-планарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в источниках вторичного электропитания. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами. Масса транзистора не более 30 г.



2Т847(А,Б)

### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кэ}=3$  В,  $I_{к}=15$  А:

$T = +25^{\circ}\text{C}$  .....  
 $T = +100$  и  $-45^{\circ}\text{C}$ , не менее .. .. .

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кэ} = 10$  В,  $I_{к} = 1,5$  А:

2Т847А  
 не менее .....  
 типовое значение .. .. .

2Т847Б не менее .. .. .

Граничное напряжение при  $I_{к} = 0,1$  А,  $I_{к,нас} = 0,3$  А,  $L = 25$  мГн, не менее .. .. .

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_{к}=15$  А,  $I_{б} = 5$  А .. .. . 0,2\*

Время рассасывания при  $U_{кэ} = 200$  В,  $I_{к} = 15$  А,  $I_{б} = 3$  А,  $U_{бэ} = 7,5$  В, не более .. .. .

Время спада при  $U_{кэ} = 200$  В,  $I_{к} = 15$  А,  $I_{б} = 3$  А,  $U_{бэ} = 7,5$  В, не более .. .. .

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кб} = 400$  В, не более .. .. .  
 типовое значение .. .. .

Обратный ток коллектора, не более:

$T = +25^{\circ}\text{C}$  при  $U_{кб} = 650$  В .. .. .  
 $T = +100^{\circ}\text{C}$  при  $U_{кб} = 400$  В .. .. .  
 $T = -45^{\circ}\text{C}$  при  $U_{кб} = 650$  В .. .. .

Обратный ток эмиттера при  $U_{бэ} = 8$  В, не более .. .. .

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер <sup>1</sup> при $R_{бэ} = 10$ Ом, $T_{к} = -45 \dots +75^{\circ}\text{C}$ .. .. .	650 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 10$ Ом, $t_{и} = 20$ мкс, $t_{ф} = 1,5$ мкс, $T_{к} = -45 \dots +75^{\circ}\text{C}$ .. .. .	650 В
Постоянное напряжение база-эмиттер .. .. .	8 В
Постоянный ток коллектора .. .. .	15 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 2$ мс .. .. .	25 А
Постоянный ток базы .. .. .	5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>2</sup> при $T_{к} = -45 \dots +25^{\circ}\text{C}$ .. .. .	125 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода .. .. .	$+200^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды .. .. .	$-45^{\circ}\text{C}$ $T_{к} = +100^{\circ}\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_{к} > +75^{\circ}\text{C}$  максимально допустимые постоянное и импульсное напряжения коллектор-эмиттер снижаются линейно до 350 В при  $T_{к} = +100^{\circ}\text{C}$

<sup>2</sup> При  $T_{к} = > +25^{\circ}\text{C}$  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к, макс} = (200 - T_{к}) / R_{т(n-k)}, \text{ Вт}$$

где  $R_{т(n-k)} = 0,7^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$  при  $U_{кэ} = 10$  В,  $I_{к} = 12,5$  А

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре припоя  $+260^{\circ}\text{C}$  в течение не более 3 с